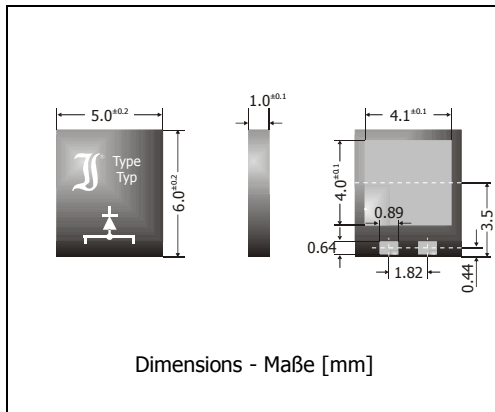



SK1520PQ ... SK15100PQ

Surface Mount Schottky Rectifier Diodes Schottky-Gleichrichterdioden für die Oberflächenmontage

Version 2011-05-26



Nominal Current – Nennstrom	15 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...100 V
Plastic case – Kunststoffgehäuse PowerQFN 5x6	5.0 x 6.0 x 1.0 [mm]
Weight approx. – Gewicht ca.	0.1 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	

Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Type Typ ¹⁾	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]	Forward Voltage Durchlass-Spannung V_F [V] ^{2) 3)}	
			$I_F = 5$ A	$I_F = 15$ A
SK1520PQ	20	20	< 0.45	< 0.55
SK1530PQ	30	30	< 0.45	< 0.55
SK1540PQ	40	40	< 0.45	< 0.55
SK1550PQ	50	50	< 0.61	< 0.68
SK1560PQ	60	60	< 0.61	< 0.68
SK1580PQ	80	80	< 0.75	< 0.83
SK15100PQ	100	100	< 0.75	< 0.83

Max. average forward rectified current, R-load Dauerstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	15A ²⁾
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15$ Hz	I_{FRM}	55 A ²⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	280/320 A ²⁾
Rating for fusing, $t < 10$ ms Grenzlastintegral, $t < 10$ ms	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	390 A ² s ²⁾
Junction temperature – Sperrschichttemperatur ... in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb		T_j	-50...+150°C $\leq 200^\circ\text{C}$
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	-50...+175°C

1 50 V to 100 V types on request – 50 V bis 100 V Ausführung auf Anfrage

2 $T_j = 25^\circ\text{C}$

3 Both anode pins connected – Beide Anodenanschlüsse kontaktiert

Characteristics

Kennwerte

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R I_R	< 500 μA < 15 mA
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht - Gehäuse			R_{thC}	< 2.0 K/W

